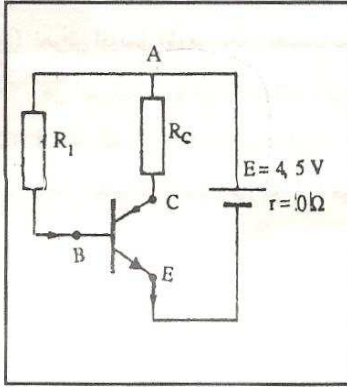


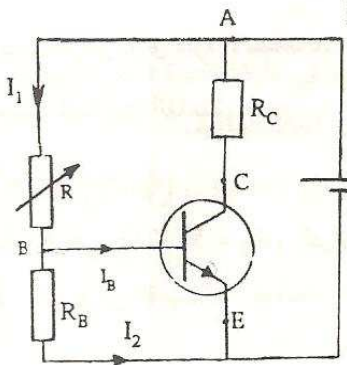
## سلسلة الترانزستور

### تمرين-1



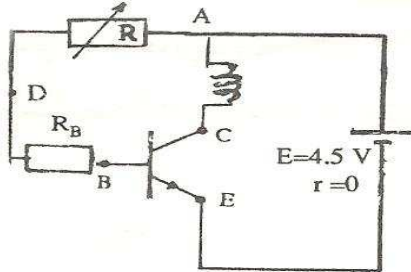
- تعتبر التركيب الممثل جانبه. عندما يشتغل الترانزستور في الحالة العادية، يكون معامل تضخيم التيار  $\beta = 100$  و التوتر  $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$  ثابت.  $R_C = 100 \Omega$ .
- (1) شدة التيار في دائرة المجمع  $I_C = 30 \text{ mA}$  و الترانزستور يشتغل في الحالة العادية.
- (1.1) أوجد قيمة  $U_{CE}$ ، التوتر بين الباعث و المجمع.
- (2) أوجد قيمة شدة التيار في دائرة القاعدة.
- (3.1) استنتج قيمة المقاومة  $R_1$ .
- (2) عوض الموصل الأومي ذي المقاومة  $R_1$  بموصل أومي مقاومته  $R_2 \approx 7,2 \text{ K} \Omega$ .
- حدد حالة اشتغال الترانزستور، علما أن شدة التيار في دائرة القاعدة هي  $I_{B2} = 0,5 \text{ mA}$ .

### تمرين-2



- تعتبر التركيب الممثل جانبه. تركيبا إلكترونيا يضم ترانزستور له تضخيم لتيار  $\beta = 200$  و توتر العتبة للوصلة (B - E) :  $U_{BE0} = 0,6 \text{ V}$ . نعطي:
- $R_B = 1 \text{ k} \Omega$  و  $R_C = 500 \Omega$  و R قابلة للضبط.
- (1) أوجد شدة تيار الاشباع في دائرة المجمع.
- (2) لضبط R عند قيمة  $R_1 = 13 \text{ K} \Omega$  فنحصل على  $U_{BE} = 0,8 \text{ V}$ .
- (1.2) أوجد  $I_B$  شدة التيار في القاعدة.
- (2.2) استنتج قيمة التوتر  $U_{CE}$ .
- (3) لضبط R عند القيمة  $R_2$  التي توافق بداية حالة الاشباع. أوجد  $R_2$ ، علما أن  $U_{BE} \approx 0,85 \text{ V}$ .

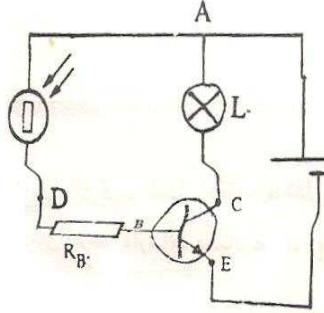
### تمرين-3



- في التركيب الممثل أسفله، يشتغل الترانزستور في النظام الخطي. التوتر  $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$  ثابت و  $\beta = 50$  ومقاومة المرحل  $R_C = 300 \Omega$ .
- يفتح المرحل دائرة الاستعمال عندما يمر في وشيعته تيار شدته أكبر من  $I_c = 10 \text{ mA}$ ، ويفتحها عندما تكون شدة التيار أصغر من  $I_d = 4 \text{ mA}$ .
- نعطي:  $R_B = 560 \Omega$  و R قابلة للضبط.
- (1) التوتر  $U_{CE} = 0,9 \text{ V}$  و  $R = R_1$ .
- (1.1) بين أن المرحل يفلق دائرة الاستعمال.
- (2.1) أوجد شدة تيار القاعدة.
- (3.1) استنتج قيمة  $R_1$ .
- (2) قيمة R هي  $R_2 = 50 \text{ K} \Omega$  و الترانزستور غير متوقف. بين أن المرحل يفتح دائرة الاستعمال

#### تمرين-4

تعتبر التركيب المبين أسفله. عند الاشتغال العادي للترانزستور، يكون معامل تضخيم التيار  $\beta = 100$  و التوتر  $U_{BE} \approx 0.6 \text{ V}$ . يضيء المصباح L عندما يجتازه تيار شدته  $I = 0.3 \text{ A}$ . للمقاومة الضوئية في الظلام، مقاومة  $R_1 = 10^6 \Omega$  و في الضوء مقاومة  $R_2 = 300 \Omega$ . مولد G قوته الكهرومحرركة  $E \approx 4,5 \text{ V}$  ومقاومته مهملة.



(1) المقاومة الضوئية في الضوء و المصباح مضيء.

(1.1) أحسب شدة تيار دائرة القاعدة.

(2.1) استنتج قيمة  $R_B$ .

المقاومة الضوئية في الظلام، بين أن المصباح لا يضيء.

(3) اقترح استعمالات ممكنة لهذا التركيب.

#### تمرين-5

نعتبر التركيب الممثل أسفله. خلال الاشتغال العادي للترانزستور، يكون معامل تضخيم التيار  $\beta = 200$  و التوتر  $U_{BE} = 0.6 \text{ V}$ . يتطلب تشغيل المصباح L تيارا شدته  $I = 0.2 \text{ A}$ . للمقاومة الحرارية، عند درجة الحرارة  $\theta_1 = 20^\circ \text{C}$ ، مقاومة

$R_1 = 600 \Omega$  وعند  $\theta_2 = 60^\circ \text{C}$ ، مقاومة  $R_2 = 200 \Omega$ .

(1) المقاومة الحرارية عند درجة الحرارة  $\theta_1$  و المصباح مضيء.

(1.1) أحسب شدة التيار في القاعدة.

(2.1) أوجد  $I_1$ ، شدة التيار في الموصل (AB).

(3.1) استنتج قيمة R، مقاومة الموصل الأومي (AB).

(2) المقاومة الحرارية عند درجة الحرارة  $\theta_2$ .

(1.2) بين أن الترانزستور متوقف.

(2.2) اقترح بعض الاستعمالات الممكنة لهذا التركيب.

